

双节锂离子/锂聚合物电池保护 IC ME4212

概述

ME4212 系列 IC，是一款双节锂离子/锂聚合物电池保护 IC，内置高精度电压检测电路和延时电路，适合对双节串联可再充电锂离子/锂聚合物电池的过充电、过放电和过电流进行保护；芯片工作电压 1.5V~10V，连接充电器端子耐高压设计(绝对最大额定值 33V)，零伏电池充电功能可选，正常工作时 5.0 uA 低静态电流，休眠时耗电流不超过 0.1uA.

特点

(1) 高精度电压检测

- | | | |
|------------------------------|---------------|----------------|
| ● 过充电检测电压 V_{CUn} (n=1, 2) | 4.10V~4.50V | 精度 $\pm 25mV$ |
| ● 过充电解除电压 V_{CRn} (n=1, 2) | 3.90V~4.30V | 精度 $\pm 50mV$ |
| ● 过放电检测电压 V_{DLn} (n=1, 2) | 2.00V~3.20V | 精度 $\pm 80mV$ |
| ● 过放电解除电压 V_{DRn} (n=1, 2) | 2.30V~3.40V | 精度 $\pm 100mV$ |
| ● 放电过流检测电压 | 0.10V~0.35V | 精度 $\pm 30mV$ |
| ● 充电过流检测电压 | -0.31V~-0.11V | 精度 $\pm 30mV$ |
| ● 负载短路检测电压 | 1.0V (固定) | 精度 $\pm 0.4V$ |

(2) 各延迟时间由内部电路设置 (不需外接电容)

- | | |
|--------------|-----------------|
| ● 过充电检测延迟时间 | 典型值 1000ms |
| ● 过放电检测延迟时间 | 典型值 100ms |
| ● 放电过流检测延迟时间 | 典型值 10ms |
| ● 充电过流检测延迟时间 | 典型值 7ms |
| ● 负载短路检测延迟时间 | 典型值 250 μ s |

(3) 低耗电流

- | | |
|--------|---|
| ● 工作模式 | 典型值 5.0 μ A，最大值 9.0 μ A (VC=3.9V, VDD=7.8V) |
| ● 休眠模式 | 最大值 0.1 μ A (VC=2.0V, VDD=4.0V) |

(4) 连接充电器的端子采用高耐压设计 (CS 端子和 OC 端子，绝对最大额定值是 33V)

(5) 向 0V 电池充电功能：可以选择“允许”或“禁止”

(6) 宽工作温度范围：-40 $^{\circ}$ C~+85 $^{\circ}$ C

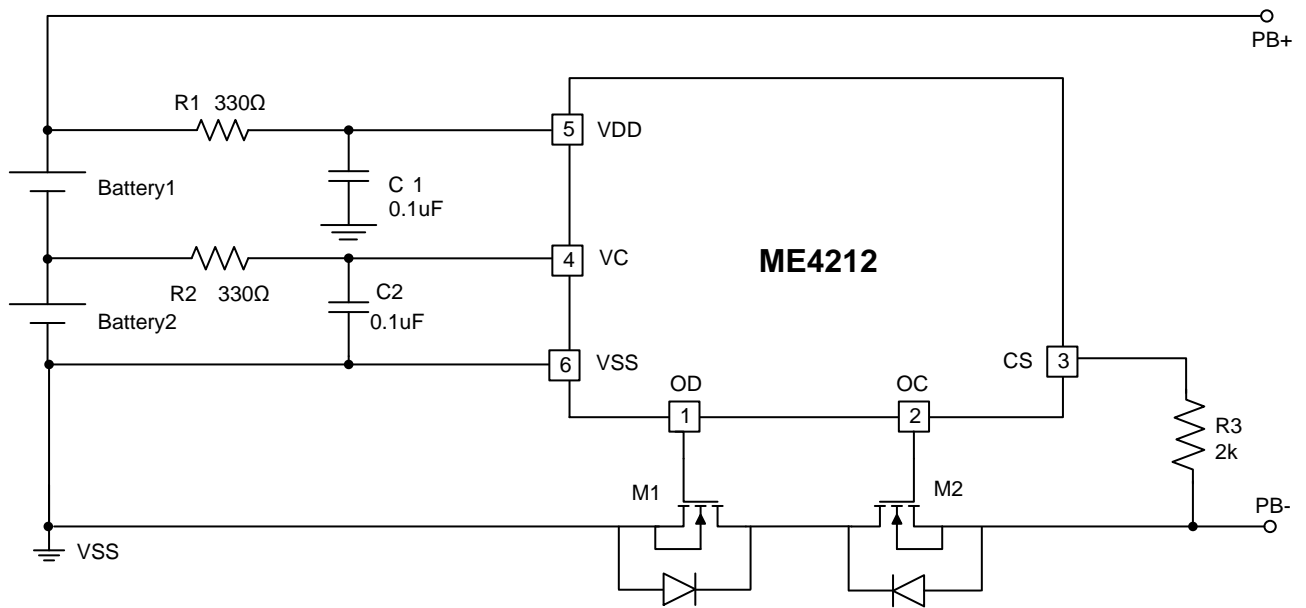
应用场合

- 对讲机
- 矿灯
- 机顶盒

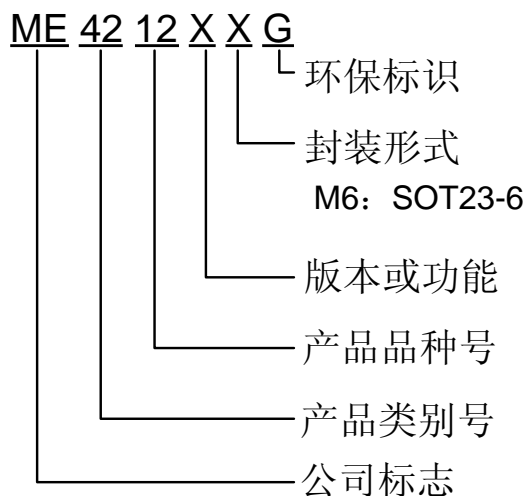
封装形式

- 6-pin SOT23-6

典型应用图



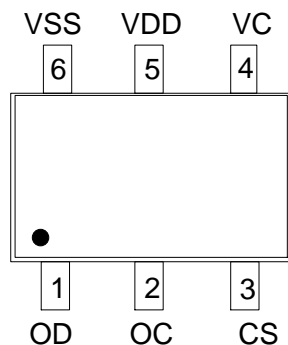
选型指南



产品型号	过充电检测电压	过充电解除电压	过放电检测电压	过放电解除电压	放电过流检测电压	充电过流检测电压	0V 电池充电功能	过放电是否休眠
ME4212AM6G	4.28±0.025V	4.08±0.05V	2.90±0.08V	3.00±0.1V	200±30mV	-200±30mV	允许	休眠
ME4212BM6G	4.35±0.025V	4.15±0.05V	2.30±0.08V	3.00±0.1V	200±30mV	-200±30mV	允许	休眠
ME4212CM6G	4.28±0.025V	4.08±0.05V	2.25±0.08V	2.95±0.1V	200±30mV	-200±30mV	允许	休眠
ME4212DM6G	4.28±0.025V	4.08±0.05V	2.80±0.08V	3.00±0.1V	200±30mV	-200±30mV	允许	自恢复
ME4212EM6G	4.25±0.025V	4.05±0.05V	2.50±0.08V	3.00±0.1V	100±30mV	-100±30mV	允许	休眠
ME4212FM6G	4.25±0.025V	4.05±0.05V	2.70±0.08V	3.00±0.1V	100±30mV	-100±30mV	允许	休眠
ME4212HM6G	4.25±0.025V	4.05±0.05V	2.50±0.08V	3.00±0.1V	200±30mV	-200±30mV	允许	自恢复
ME4212JM6G	4.25±0.025V	4.25-0.035V, 4.25±0.025V	2.80±0.08V	3.00±0.1V	200±30mV	-200±30mV	允许	自恢复
ME4212LM6G	4.225±0.025V	3.98±0.05V	2.79±0.08V	3.00±0.1V	100±30mV	-100±30mV	允许	休眠

注：如您需要其他电压值或封装形式的产品，请联系我司销售人员

芯片脚位图

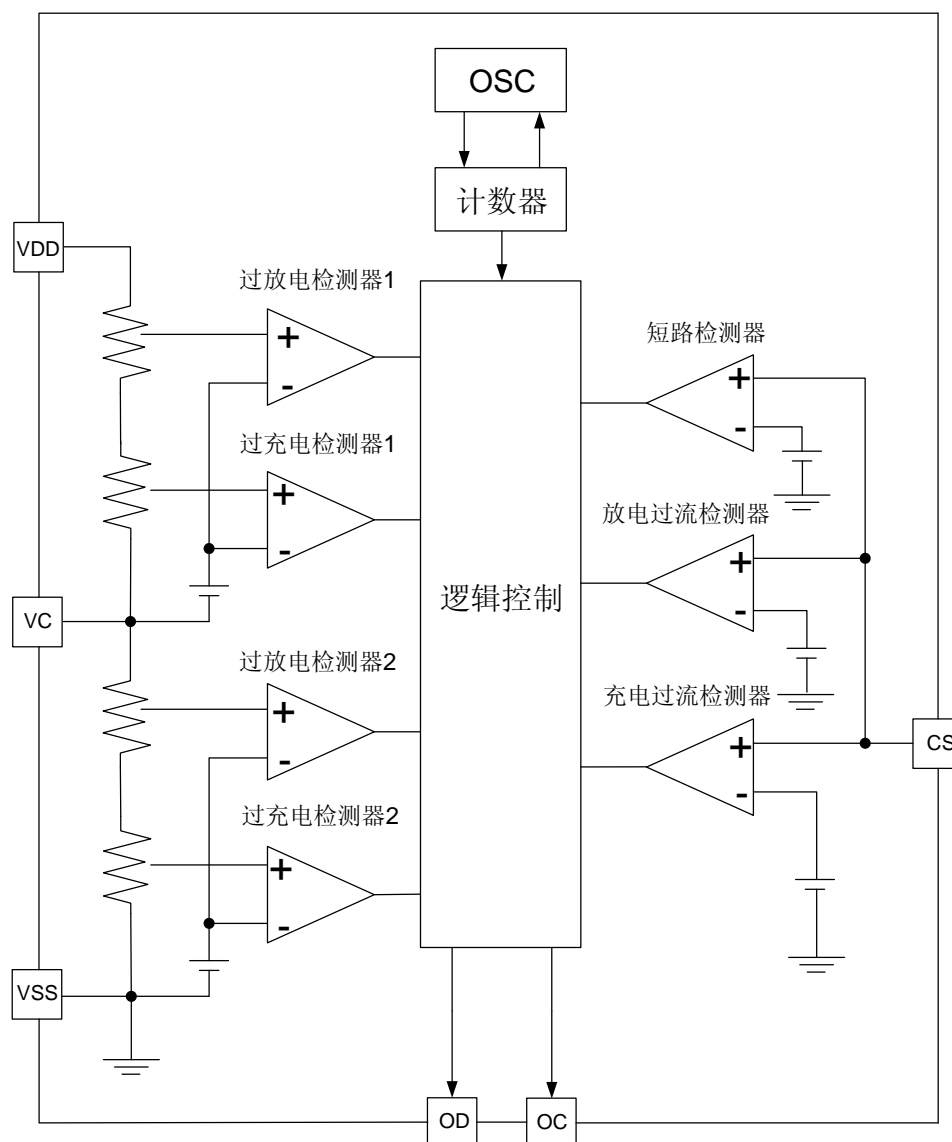


SOT23-6

脚位功能说明

PIN 脚位	符号名	功能说明
1	OD	放电控制用 MOSFET 门极连接端子
2	OC	充电控制用 MOSFET 门极连接端子
3	CS	过电流检测输入端子，充电器检测端子
4	VC	电池 1 负极、电池 2 正极连接端子
5	VDD	正电源输入端子，电池 1 正极连接端子
6	VSS	接地端，负电源输入端子，电池 2 负极连接端子

芯片功能示意图



绝对最大额定值

参数	符号	极限值	单位
VDD和VSS间输入电压	V_{DD}	-0.3~10	V
OC输出电压	V_{OC}	$V_{DD}-33 \sim V_{DD}+0.3$	V
OD输出电压	V_{OD}	-0.3~ $V_{DD}+0.3$	V
CS 输入端子电压	V_{CS}	$V_{DD}-33 \sim V_{DD}+0.3$	V
工作环境温度范围	T_{op}	-40 ~ 85	°C
储存温度范围	T_{ST}	-55 ~ 150	°C
结温范围	T_J	-40 ~ 150	°C
封装功耗 (SOT23-6)	P_D	0.63	W
封装热阻 (SOT23-6)	θ_{JA}	200	°C/W

注意：绝对最大额定值是本产品能够承受的最大物理伤害极限值，请在任何情况下勿超出该额定值。

ME4212 电气参数

(正常条件 Ta= 25 °C, VSS=0V, 除非另行标注)

项目	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压						
VDD-VSS 工作电压	V _{DS1}	-	1.5	-	10	V
VDD-CS 工作电压	V _{DS2}	-	1.5	-	33	V
消耗电流						
工作电流	I _{DD}	VC=3.9V, VDD=7.8V	-	5.0	9.0	uA
休眠电流	I _{PD}	VC=2.0V, VDD=4.0V	-	-	0.1	uA
检测及解除电压						
过充电检测电压 n (1, 2)	V _{CU_n}	4.1~4.5V, 可选	V _{CU_n} -0.025	V _{CU_n}	V _{CU_n} +0.025	V
过充电解除电压 n (1, 2)	V _{CR_n}	3.9~4.3V, 可选	V _{CR_n} -0.05	V _{CR_n}	V _{CR_n} +0.05	V
过放电检测电压 n (1, 2)	V _{DL_n}	2.0~3.2V, 可选	V _{DL_n} -0.08	V _{DL_n}	V _{DL_n} +0.08	V
过放电解除电压 n (1, 2)	V _{DR_n}	2.3~3.4V, 可选	V _{DR_n} -0.1	V _{DR_n}	V _{DR_n} +0.1	V
放电过流检测电压	V _{DIP}	-	V _{DIP} -30	V _{DIP}	V _{DIP} +30	mV
负载短路检测电压	V _{SHORT}	VDD-VSS=7.0V	0.6	1.0	1.4	V
充电过流检测电压	V _{CIP}	-	V _{CIP} -30	V _{CIP}	V _{CIP} +30	mV
保护延时						
过充电保护延时	T _{OC}	-	700	1000	1300	ms
过放电保护延时	T _{OD}	-	70	110	150	ms
放电过流保护延时	T _{DIP}	-	6	10	14	ms
充电过流保护延时	T _{CIP}	-	4	7	10	ms
短路保护延时	T _{SHORT}	-	150	250	400	us
输出端子电压						
OC 端子高电平	V _{OCH}	-	VDD-0.1	VDD-0.02	-	V
OC 端子低电平	V _{OCL}	-	-	0.2	0.5	V
OD 端子高电平	V _{ODH}	-	VDD-0.1	VDD-0.02	-	V
OD 端子低电平	V _{ODL}	-	-	0.2	0.5	V
0V 电池充电功能(允许或禁止)						
充电器起始电压	V _{OVCL}	允许向 0V 电池充电功能	1.2	-	-	V
电池电压	V _{OVCH}	禁止向 0V 电池充电功能	-	-	0.5	V

工作说明

a. 正常工作状态

ME4212 系列 IC 持续检测连接在 VDD 与 VC 端子之间电池 1 的电压、连接在 VC 与 VSS 端子之间电池 2 的电压，以及 CS 与 VSS 端子之间的电压差，来控制充电和放电。当电池 1 和电池 2 的电压都在过放电检测电压 (V_{DLn}) 以上并在过充电检测电压 (V_{CU_n}) 以下，且 CS 端子电压在充电过流检测电压 (V_{CIP}) 以上并在放电过流检测电压 (V_{DIP}) 以下时，IC 的 OC 和 OD 端子都输出高电平，使充电控制用 MOSFET 和放电控制用 MOSFET 同时导通，这个状态称为“正常工作状态”。此状态下充电和放电都可以自由进行。

注意：初次连接电芯时，会有不能放电的可能性，此时，短接 CS 端子和 VSS 端子，或者连接充电器，就能恢复到正常工作状态。

b. 过充电状态

正常工作状态下的电池，在充电过程中，连接在 VDD 与 VC 端子之间电池 1 的电压或连接在 VC 与 VSS 端子之间电池 2 的电压，超过过充电检测电压 (V_{CU_n})，并且这种状态持续的时间超过过充电保护延迟时间 (T_{OC}) 时，IC 的 OC 端子输出电压由高电平变为低电平，关闭充电控制用的 MOSFET (OC 端子) 停止充电，这个状态称为“过充电状态”。

过充电状态在如下两种情况下可以释放，OC 端子输出电压由低电平变为高电平，使充电控制用 MOSFET 导通。

(1) 断开充电器，由于自放电使电池 1 和电池 2 的电压都降低到过充电解除电压 (V_{CRn}) 以下时，过充电状态释放，恢复到正常工作状态。

(2) 断开充电器，连接负载，当电池 1 和电池 2 的电压都降低到过充电检测电压 (V_{CU_n}) 以下时，过充电状态释放，恢复到正常工作状态。

注意：

①进入过充电状态的电池，如果仍然连接着充电器，即使电池 1 和电池 2 的电压都低于过充电解除电压 (V_{CRn})，过充电状态也不能释放。断开充电器，CS 端子电压上升到充电过流检测电压 (V_{CIP}) 以上时，过充电状态才能释放。

②当电池 1 或电池 2 的电压超过过充电检测电压 (V_{CU_n})，断开充电器并连接负载，如果电池 1 或电池 2 的电压仍不能降低到过充电检测电压 (V_{CU_n}) 以下，此时放电电流通过充电控制用 MOSFET 的寄生二极管流过，当电池 1 和电池 2 的电压都降低到过充电检测电压 (V_{CU_n}) 以下时，OC 端子输出电压由低电平变为高电平，使充电控制用 MOSFET 导通。

③当电池 1 或电池 2 的电压超过过充电检测电压 (V_{CU_n})，但在过充电保护延迟时间 (T_{OC}) 之内，电池 1 和电池 2 的电压又降低到过充电检测电压 (V_{CU_n}) 以下，则此时不进入过充电保护状态。

④OC 端子高电平是上拉到 VDD 端子，OC 端子低电平是下拉到 CS 端子。

c. 过放电及休眠状态

正常工作状态下的电池，在放电过程中，连接在 VDD 与 VC 端子之间电池 1 的电压或连接在 VC 与 VSS 端子之间电池 2 的电压，降低到过放电检测电压 (V_{DLn}) 以下，并且这种状态持续的时间超过过放电保护延迟时间 (T_{OD}) 时，IC 的 OD 端子输出电压由高电平变为低电平，关闭放电控制用的 MOSFET (OD 端子) 停止放电，这个状态称为“过放电状态”。

当关闭放电控制用 MOSFET 后，CS 由 IC 内部电阻上拉到 VDD，使 IC 耗电流减小到休眠时的耗电流值 ($<0.1\mu A$)，这个状态称为“休眠状态”。

过放电状态在以下两种情况下可以释放，OD 端子输出电压由低电平变为高电平，使放电控制用 MOSFET 导通。

(1) 连接充电器，若 CS 端子电压低于充电过流检测电压 (V_{CIP})，当电池 1 和电池 2 的电压都高于过放电检测电压 (V_{DLn}) 时，过放电状态释放，恢复到正常工作状态。

(2) 连接充电器，若 CS 端子电压高于充电过流检测电压 (V_{CIP})，当电池 1 和电池 2 的电压都高于过放电解除电压 (V_{DRn}) 时，过放电状态释放，恢复到正常工作状态。

注意：

① 电池 1 或电池 2 的电压低于过放电检测电压 (V_{DLn})，但在过放电保护延迟时间 (T_{OD}) 之内，电池 1 和电池 2 的电压又回升到过放电检测电压 (V_{DLn}) 以上，则此时不进入过放电保护状态。

② OD 端子高电平是上拉到 VDD 端子，OD 端子低电平是下拉到 VSS 端子。

d. 放电过流状态 (放电过流检测和负载短路检测功能)

正常工作状态下的电池，IC 通过检测 CS 端子电压持续侦测放电电流。一旦 CS 端子电压超过放电过流检测电压 (V_{DIP})，并且这种状态持续的时间超过放电过流保护延迟时间 (T_{DIP})，则 OD 端子输出电压由高电平变为低电平，关闭放电控制用的 MOSFET (OD 端子) 停止放电，这个状态称为“放电过流状态”。

而一旦 CS 端子电压超过负载短路检测电压 (V_{SHORT})，并且这种状态持续的时间超过负载短路保护延迟时间 (T_{SHORT})，则 OD 端子输出电压也由高电平变为低电平，关闭放电控制用的 MOSFET (OD 端子) 停止放电，这个状态称为“负载短路状态”。

放电过流状态和负载短路状态的释放，连接在电池正极 (PB+) 和电池负极 (PB-) 之间的阻抗大于 $450k\Omega$ (typ.) 时。另外，即使连接在电池正极 (PB+) 和电池负极 (PB-) 之间的阻抗小于 $450k\Omega$ (typ.) 时，当连接上充电器，使 CS 端子电压降低到放电过流保护电压 (V_{DIP}) 以下，也会解除放电过流状态或负载短路状态，回到正常工作状态。

e. 充电过流状态

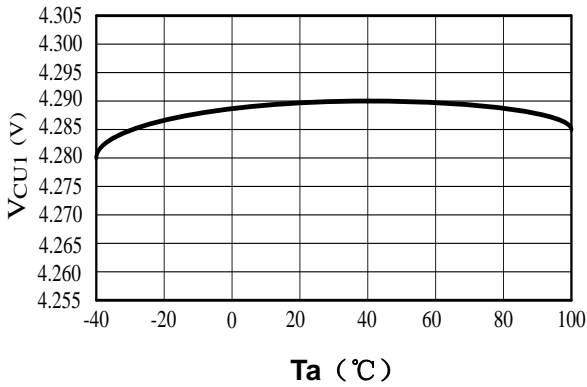
正常工作状态下的电池，在充电过程中，如果 CS 端子电压低于充电过流检测电压 (V_{CIP})，并且这种状态持续的时间超过充电过流保护延迟时间 (T_{CIP})，则 OC 端子输出电压由高电平变为低电平，关闭充电控制用的 MOSFET (OC 端子) 停止充电，这个状态称为“充电过流状态”。

进入充电过流检测状态后，如果断开充电器使 CS 端子电压高于充电过流检测电压 (V_{CIP}) 时，充电过流状态被解除，恢复到正常工作状态。

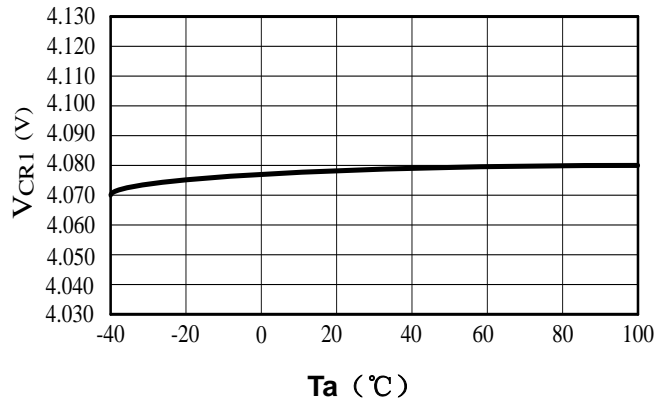
典型性能曲线图

a. 过充电检测电压/过充电解除电压, 过放电检测电压/过放电解除电压, 放电过流检测电压/负载短路检测电压, 充电过流检测电压以及各保护延迟时间随温度变化

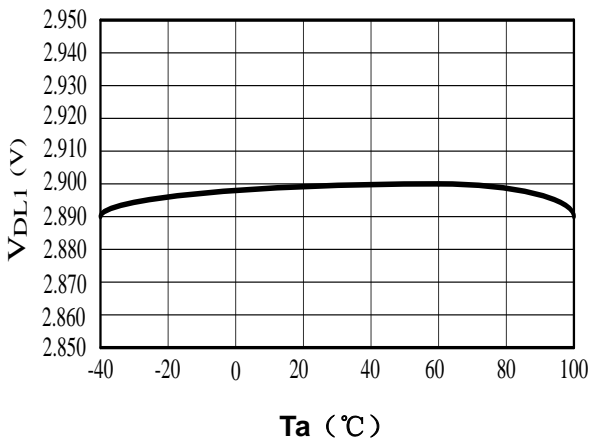
(1) V_{CU1} VS T_a



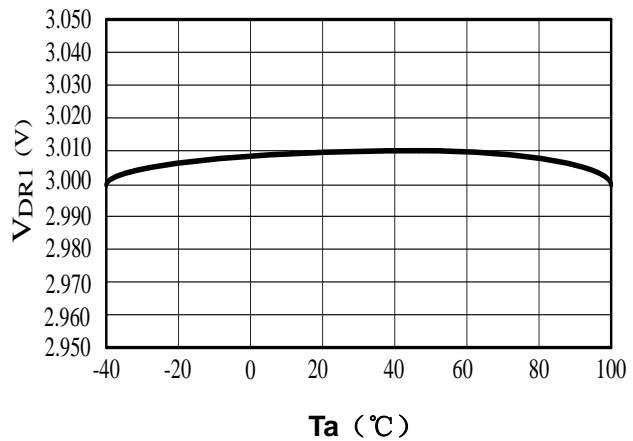
(2) V_{CR1} VS T_a



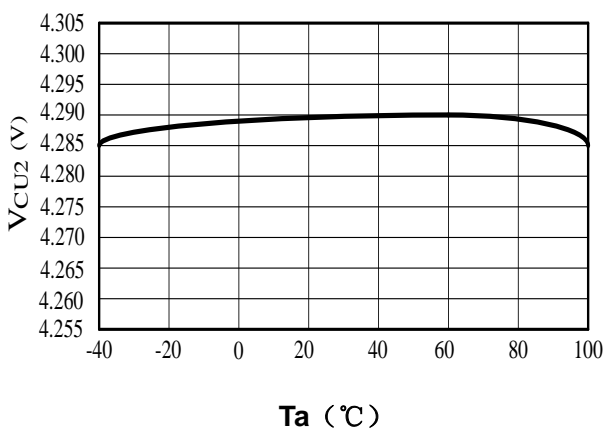
(3) V_{DL1} VS T_a



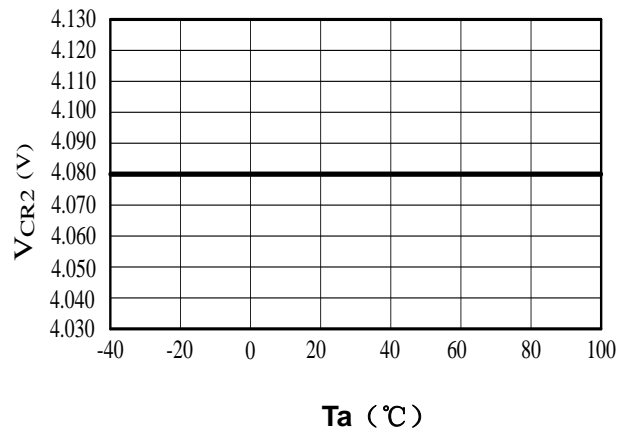
(4) V_{DR1} VS T_a



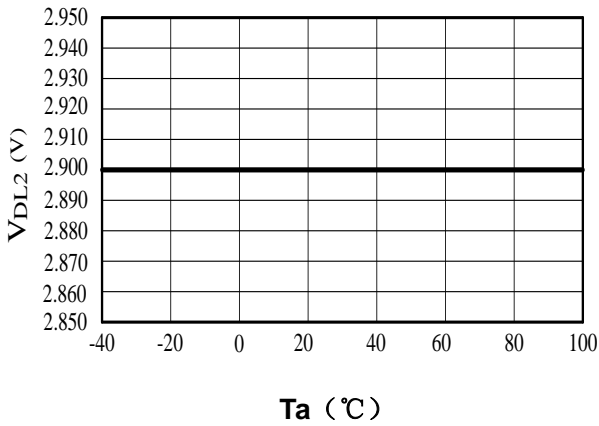
(5) V_{CU2} VS T_a



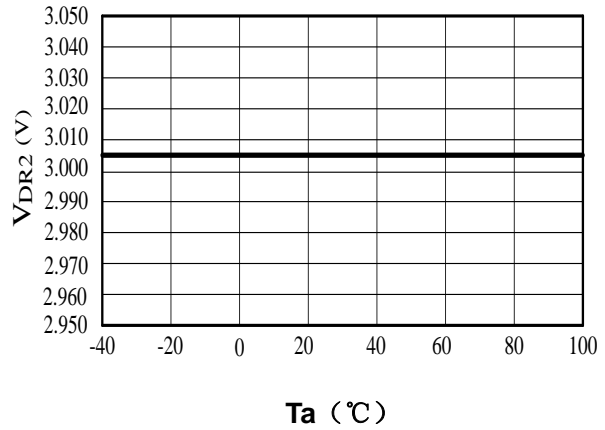
(6) V_{CR2} VS T_a



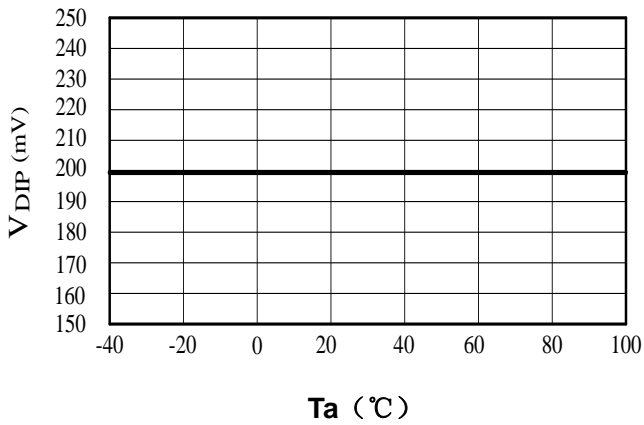
(7) V_{DL2} VS T_a



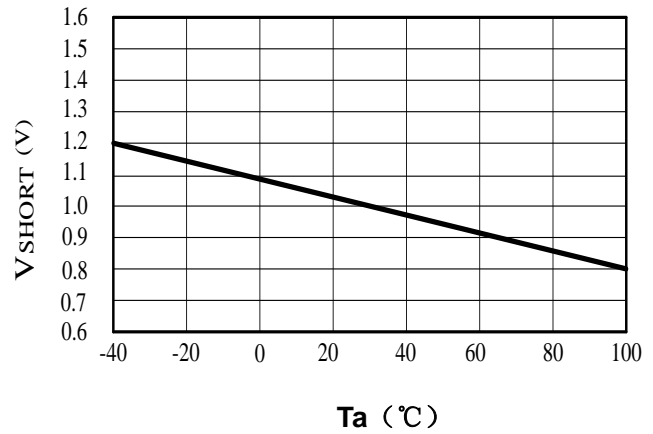
(8) V_{DR2} VS T_a



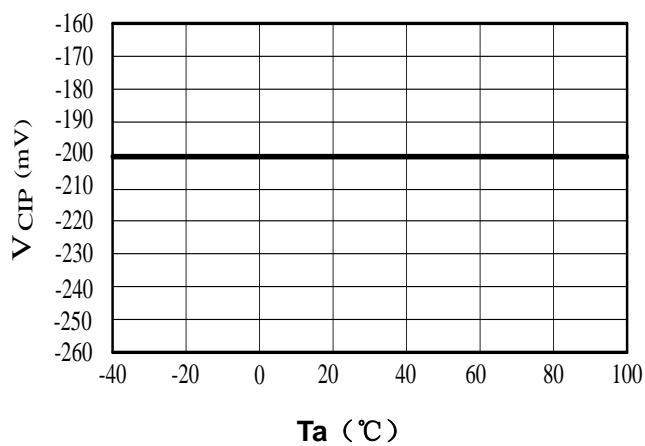
(9) V_{DIP} VS T_a



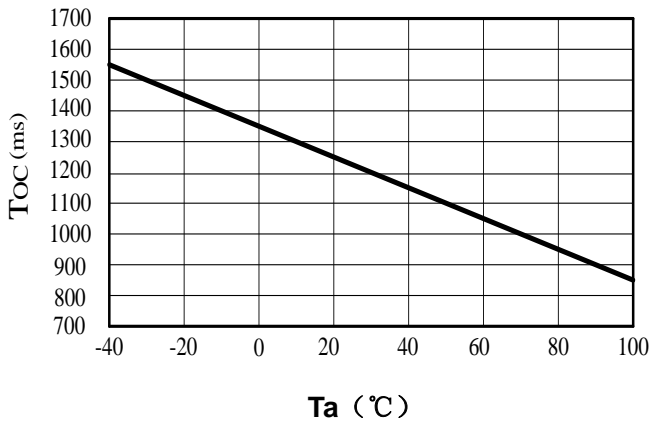
(10) V_{SHORT} VS T_a



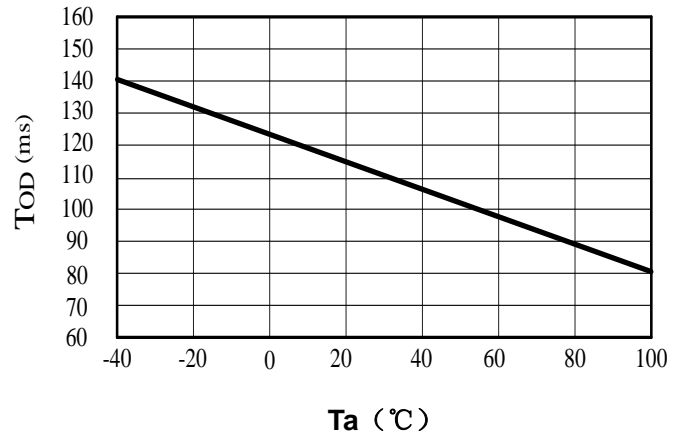
(11) V_{CIP} VS T_a



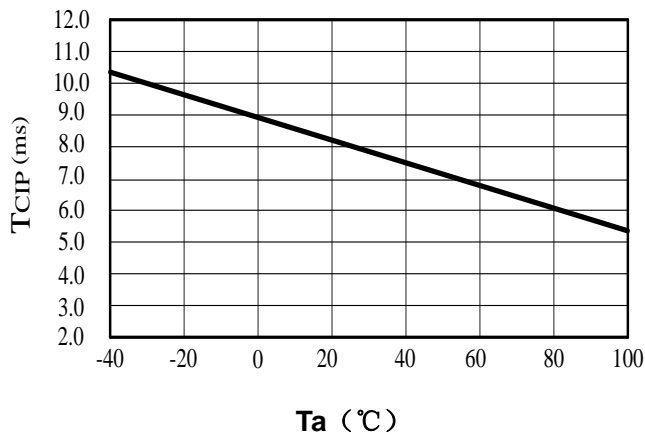
(12) T_{OC} VS T_a



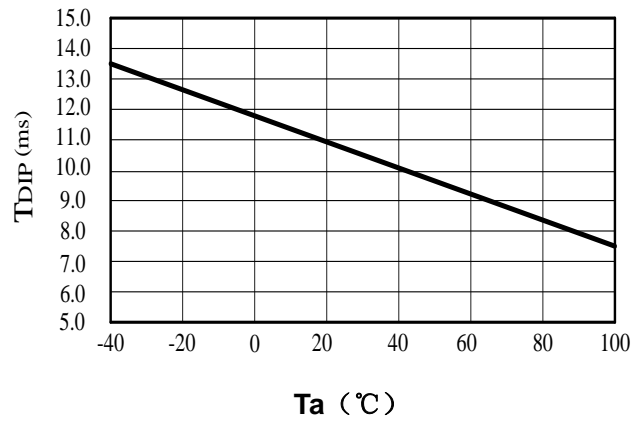
(13) T_{OD} VS T_a



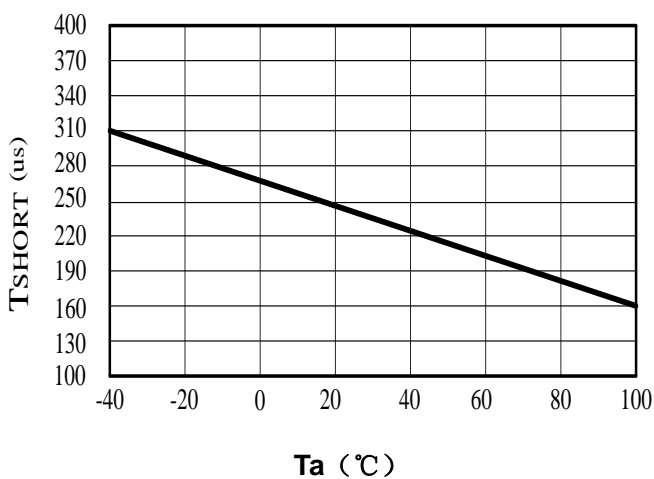
(14) T_{CIP} VS T_a



(15) T_{DIP} VS T_a

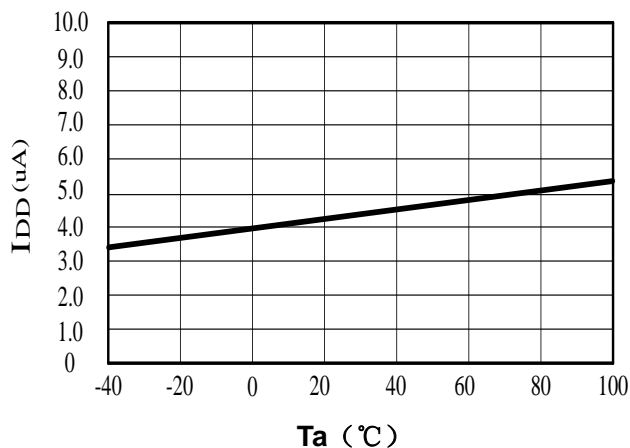


(16) T_{SHORT} VS T_a

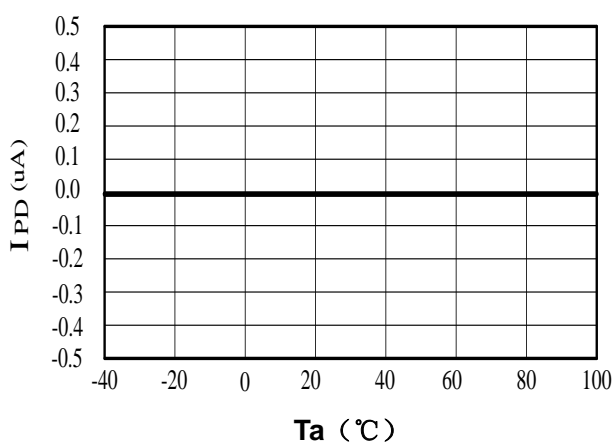


b. 耗电流随温度变化

(17) I_{DD} VS T_a



(18) I_{PD} VS T_a



应用信息

器件名称	类别	用途	最小值	典型值	最大值	说明
R1	电阻	限流、稳定 VDD、加强 ESD	100Ω	330Ω	470Ω	1
R2	电阻	限流、稳定 VC、加强 ESD	100Ω	330Ω	470Ω	1
R3	电阻	限流	1KΩ	2KΩ	4KΩ	2
C1	电容	滤波，稳定 VDD	0.01uF	0.1uF	1.0uF	3
C2	电容	滤波，稳定 VC	0.01uF	0.1uF	1.0uF	3
M1	N-MOSFET	放电控制	-	-	-	4
M2	N-MOSFET	充电控制	-	-	-	5

1、R1或R2连接过大电阻，由于耗电流会在R1或R2上产生压降，影响检测电压精度；当充电器反接时，电流从充电器流向IC，若R1或R2过大有可能导致VDD-VSS端子间电压超过绝对最大额定值的情况发生。

2、R3连接过大电阻，当连接高电压充电器时，有可能导致不能切断充电电流的情况发生。但为控制充电器反接时的电流，请尽可能选取较大的阻值。

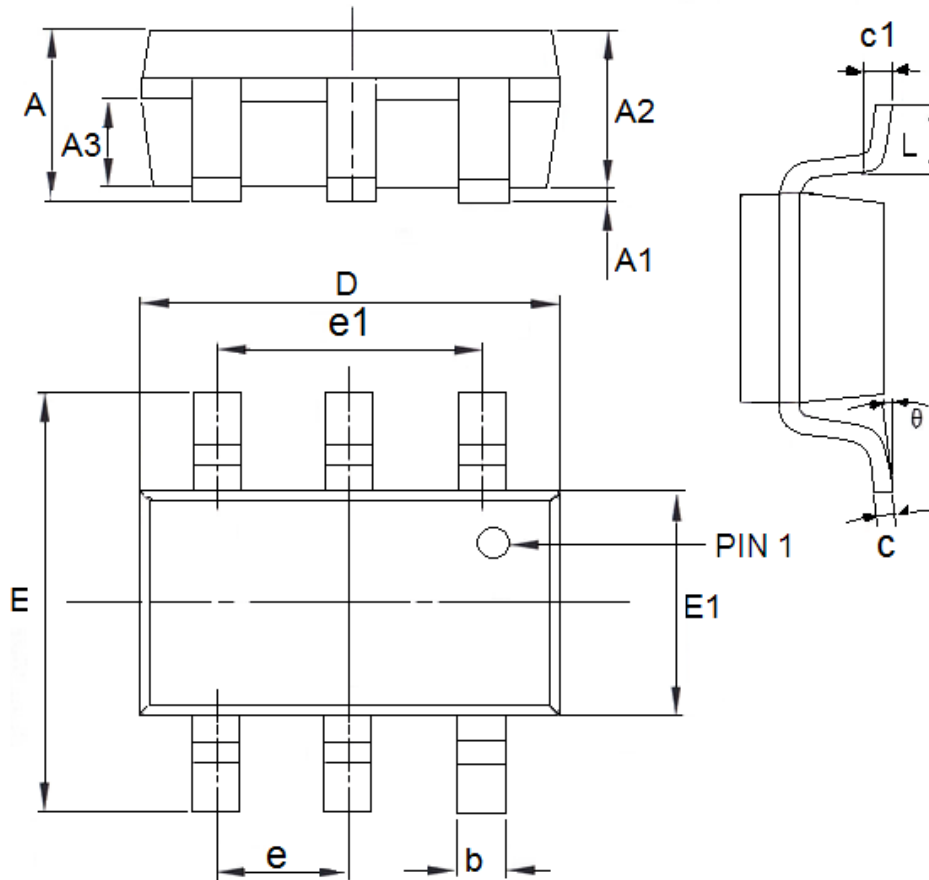
3、C1和C2有稳定VDD、VC电压的作用，请不要连接0.01μF以下的电容。

4、使用MOSFET的阈值电压在过放电检测电压以上时，可能导致在过放电保护之前停止放电。

5、门极和源极之间耐压在充电器电压以下时，N-MOSFET有可能被损坏。

封装信息

- 封装类型: SOT23-6



参数	尺寸 (mm)		尺寸 (Inch)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	1.05	1.45	0.0413	0.0571
A1	0	0.15	0.0000	0.0059
A2	0.9	1.3	0.0354	0.0512
A3	0.55	0.75	0.0217	0.0295
b	0.25	0.5	0.0098	0.0197
c	0.1	0.25	0.0039	0.0098
D	2.7	3.12	0.1063	0.1228
e1	1.9(TYP)		0.0748(TYP)	
E	2.6	3.1	0.1024	0.1220
E1	1.4	1.8	0.0551	0.0709
e	0.95(TYP)		0.0374(TYP)	
L	0.25	0.6	0.0098	0.0236
θ	0	8°	0.0000	8°
c1	0.2(TYP)		0.0079(TYP)	

- 本资料内容，随产品的改进，会进行相应更新，恕不另行通知。使用本资料前请咨询我司销售人员，以保证本资料内容为最新版本。
- 本资料所记载的应用电路示例仅用作表示产品的代表性用途，并非是保证批量生产的设计。
- 请在本资料所记载的极限范围内使用本产品，因使用不当造成的损失，我司不承担其责任。
- 本资料所记载的产品，未经本公司书面许可，不得用于会对人体产生影响的器械或装置，包括但不限于：健康器械、医疗器械、防灾器械、燃料控制器械、车辆器械、航空器械及车载器械等。
- 尽管本公司一向致力于提高产品质量与可靠性，但是半导体产品本身有一定的概率发生故障或错误工作，为防止因此类事故而造成的人身伤害或财产损失，请在使用过程中充分留心备用设计、防火设计、防止错误动作设计等安全设计。
- 将本产品或者本资料出口海外时，应当遵守适用的进出口管制法律法规。
- 未经本公司许可，严禁以任何形式复制或转载本资料的部分或全部内容。